
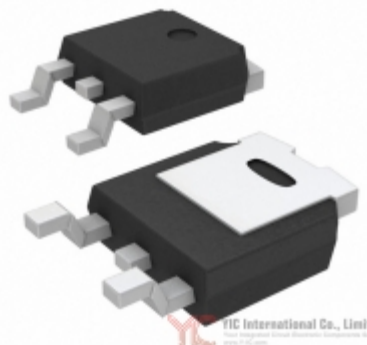










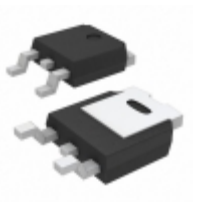
| | |
|--|--|
|   | <p>Hersteller-Teilenummer: STD18N55M5</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> |
| <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 550V 13A DPAK</p> | <p>Datenblätter:  STD18N55M5.pdf</p> |
| <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> | <p>Lagerzustand: New original, 36300 pcs Stock Available.</p> |
| <p>Lieferung von: Hong Kong</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | STD18N55M5 |
| Hersteller | STMicroelectronics |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 550V 13A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 36300 pcs Stock |
| Serie | MDmesh™ V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | 150 °C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Supplier Device-Gehäuse | DPAK |
| Verlustleistung (max) | 110W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 550V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C | 16A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 192 mOhm @ 8A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 31nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1260pF @ 100V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Vgs (Max) | ±25V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

STD18N55M5 ist neu im Original, Suche STD18N55M5 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD18N55M5 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STD18N55M5: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|--|
|  STD18GK18B Sirectifi IGBT Modules |  STD18GK18 Sirectifier IGBT Modules |  STD18NF03LT4 ST STD18NF03LT4 ST |  STD18GK16 Sirectifier IGBT Modules |
|  STD18N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 15A DPAK |  STD18GK16B Sirectifier IGBT Modules |  STD1955NL S STD1955NL S |  STD18NF25 STMicroelectronics MOSFET N-CH 250V 17A DPAK |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊛ STD17NF25T4 ⊣ STD181GK08B ⊛ STD181GK16 D STD18GK08 ⇒ STD18GK14B ↔ STD18N65M5 ⊛ STD19NE06 ⊣ STD19NF20 ⊛ STD1HNC60T4G ↔ STD1NB52 | <ul style="list-style-type: none"> ↔ STD1805-1 ⊛ STD181GK12 ⊣ STD181GK16B ⊛ STD18GK08B ↔ STD18GK16 ⇒ STD18NF03L D STD19NE06L ⊛ STD1HN60K3 ⊣ STD1LNK60Z ⊛ STD1NB60T4 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ STD1805T4 D STD181GK12B ⊛ STD181GK18 ⊣ STD18GK12 ⊛ STD18GK16B D STD18NF03LT4 ⇒ STD19NE06LT4 ↔ STD1HNC60 ⊛ STD1LNK60Z-1 ⊣ STD1NB80 | <ul style="list-style-type: none"> D STD180A/1600V ⇒ STD181GK14 ↔ STD181GK18B ⊛ STD18GK12B ⊣ STD18GK18 ⊛ STD18NF25 ↔ STD19NE06T4-TR ⇒ STD1HNC60-1 D STD1N20SPY-TR ⊛ STD1NB80-1 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ STD181GK08 ⇒ STD181GK14B ⇒ STD1862Y ⇒ STD18GK14 ⇒ STD18GK18B ⊣ STD1955NL ⇒ STD19NF06L ⇒ STD1HNC60T4 ⇒ STD1NB40 ⇒ STD1NB80-T4 |
|---|---|--|--|---|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited